2010/3/16

テラビット記録のためのパターン媒体技術

北上 修, 岡本 聡, 菊池伸明 (東北大学多元研)

島津武仁, 三塚 要, 青井 基 (東北大学通研)

本研究の一部は,

文部科学省"次世代IT基盤構築のための研究開発"

文部科学省特別教育研究経費"ポストシリコン物質・デバイス創製基盤技術アライアンス" 科研費

情報ストレージ推進機構 (SRC)

の援助のもとで行われた.

内容

I. 背景

- Ⅱ.BPMテラビット記録の可能性に関する試算
- Ⅲ. BPM用磁性材料
- Ⅳ. ドット格子の問題
- V.まとめ

背 景



BPMに係わる様々な課題



BPMによるテラビット記録は原理的に可能か?

BPMテラビット記録の可能性

問題設定

BPMにより 5 Tbpsi は原理的に可能か?

[JEITA Report 『ストレージ技術調査研究報告書』21 (2007)]

BPM が満足すべき要件

- 1. 個々のドットが満たすべき条件
- 2. ドット集合体が満たすべき条件
- 3. 記録特性及び熱安定性からの要求



5 Tbpsiは原理的に可能か?

個々のドットが満たすべき条件

- B1-1. ビット占有面積 $S = (W + \delta)^2 = 130 \text{ nm}^2$ (正方ドットの場合 $W + \delta = 11.4 \text{ nm}$)
- B1-2. 垂直磁化条件

実効垂直異方性
$$K_{eff} = K_{u} + \frac{1}{2} \Big(N_{p_x, y} - N_{p_z} \Big) M_{s}^{2} = K_{u} + \frac{1}{2} \Delta N_{p_x, z} M_{s}^{2} > 0$$
(1)

B1-3. 双安定かつコヒーレントな磁化挙動

$$W \leq L_{ex} \text{ or } \delta_w$$
 (?) ·····(2)
ここで 交換結合長 $L_{ex} = \frac{2q}{M_s} \sqrt{\frac{2A}{N_{p_x}}}$ 磁壁厚 $\delta_w = \pi \sqrt{\frac{A}{K_{eff}}}$
 $\int_{V_{w,0}}^{Z} \frac{1}{V_{w,0}} \frac{1}{$

ドット集合体が満たすべき条件

この問題に入る前に、ドットや粒子集合体の磁化過程を理解しなければならない.



[O. Kitakami et al. Jpn. J. Appl. Phys. 40, 4019 (2001); ibid 41, L455 (2002)]

個々の粒子は以下の実効異方性を有する

$$K_{\rm eff} = K_{\rm u} - \frac{1}{2} \left(N_{\rm p_z} - N_{\rm p_x, y} \right) M_{\rm s}^2$$
(3)

粒子は、外部磁場に加え、自身を除いた全粒子からの双極子場(反磁場)を感じながら磁化する。その双極子場は、 集合体全体が生み出す場から自分自身が生み出す場の差分に等しく $(N_f - N_{p_z}) < M_s > 2$ なる。このような考察から 求まる磁化曲線は、上図のように反磁場係数差の逆数 1/ $(N_f - N_{p_z})$ で傾斜したものとなる。

ドット集合体が満たすべき条件

双極子相互作用が媒体設計マージンを著しく狭める

1. Increase of saturation field $H_{\rm s}$



Unfavorable for saturation recording

2. Reduction of nucleation field H_n



DC noise & ATE problem

 $H_{r} = -H_{r} + (N_{f} - N_{p}) < M_{s} > H_{s} = H_{r} + (N_{f} - N_{p}) < M_{s} > dipolar field$

Μ

3. Severe reduction of energy barrier

$$\Delta E(H_{d} = 0) = KV >> \Delta E(H_{d} = -(N_{f} - N_{p_{z}}) < M_{s} >)$$

4. Increase in effective switching field distribution

Deterioration of recording resolution $\frac{d M}{d x} = \frac{d M}{d H_{\text{loop}}} \cdot \frac{d H_{\text{head}}}{d x}$

ドット集合体が満たすべき条件

<u>粒子間の双極子相互作用は記録媒体のあらゆる性能に甚大な影響を及ぼす.本報告で取り扱</u> <u>うパターン媒体の場合も全く同様で、この相互作用の影響を如何に低減するかが媒体をデザイン</u> <u>をする上で非常に重要である.</u>但し、パターン媒体の場合に難しいのは、平均反磁場係数を通常 の薄膜のように単純にN_f ~ 4πで近似できない点にある.この具体的な計算は後ほど行うとして、 先ず記録媒体応用の観点からドット集合体にどのような性質が求められるかをまとめる.

B2-1 DCイレーズノイズ低減のためには残留磁化比が $M_r/M_s = 1$

 $H_{\rm K}^{\rm eff} > H_{\rm d}$ (dipolar field from all surrounding particles)

$$H_{K}^{eff} = 2K_{eff} / M_{s} = 2K_{u} / M_{s} + (N_{p_{x}} - N_{p_{z}})M_{s}$$

$$H_{d} = (N_{f} - N_{p_{z}}) < M_{s} >$$
(4)



記録特性及び熱安定性からの要求

B3-1 飽和記録

飽和磁場 $H_{sat} = H_{K}^{eff} + H_{d} = H_{K}^{eff} + (N_{f} - N_{p_{z}}) < M_{s} > \leq H_{head}^{max}$ (6)

* 主磁極/SULの組み合わせで双極子場は約1/3に減少.

See, for example, Report for IT21, unpublished (2003/4/25). In this calculation, I adopted the Nakamoto & Bertram's analytic model. [K. Nakamoto and H. N. Bertram, J. Magn. Soc. Jpn. **26**, 79 (2002)]

B3-2 熱安定性

5

にネルギー障壁
$$\Delta E [H_d^{max} = -(N_f - N_{p_z}) < M_s >] \ge 40 k_B T$$
(7)
 $\int I = I(2) O \exists E - U > F$ 条件より
 $\Delta E = K_{eff} V \left(1 - \frac{(N_f - N_{p_z}) < M_s >}{H_K^{eff}} \right)^2 \ge 40 k_B T$ (8)

5 Tbpsi用BPMに課される条件

- B1. 個々のドットが満たすべき条件
- B2. ドット集合体が満たすべき条件
- B3. 記録特性及び熱安定性からの要求

条件 (1), (2), (4)~(6), (8)

以上の条件式を統合・整理すると、5 Tbpsi BPMに課される条件は以下の通り.

$$(N_{f} - N_{p_{z}}) < M_{s} > \leq H_{K}^{eff} \leq H_{head}^{max} - (N_{f} - N_{p_{z}}) < M_{s} >$$

$$M_{s} V H_{K}^{eff} \left(1 - \frac{(N_{f} - N_{p_{z}}) < M_{s} >}{H_{K}^{eff}}\right)^{2} \geq 80 \ k_{B} T$$
....(9)

結局, 5 Tbpsi用パターン媒体を原理的に実現できるかどうかは, 式(9) & (10)を同時に満たす解が存在するかどうかにかかっている. これらの解の存在を見つけるには, ドット集合体の反磁界係数 N_f , 単一ドットの反磁界係数 $_{Np_x,y,z}$ を知らなければならない. そこで, 先ずこれらの反磁界係数の計算法について述べた後, 5Tbpsi用パターン媒体の条件式(9) & (10)に戻る.

見積もりに必要な反磁界係数

$$(N_{f} - N_{p_{z}}) < M_{s} > \leq H_{K}^{eff} \leq H_{head}^{max} - (N_{f} - N_{p_{z}}) < M_{s} >$$

$$M_{s} V H_{K}^{eff} \left(1 - \frac{(N_{f} - N_{p_{z}}) < M_{s} >}{H_{K}^{eff}} \right)^{2} \geq 80 k_{B} T$$

$$(10)$$

$$K_{eff} = K_{u} + \frac{1}{2} \left(N_{p_{x}, y} - N_{p_{z}} \right) M_{s}^{2} = K_{u} + \frac{1}{2} \Delta N_{p_{x}, z} M_{s}^{2} > 0$$

N_f:ドット集合体のz方向反磁界係数 (全ドット) N_{p_z}: 一つのドットの z方向反磁界係数 N_{p_x,y}: 一つのドットの x, y方向反磁界係数 N_f - N_{p_z}:自身以外のドットの影響による反磁界係数



ドットの垂直方向反磁界係数

ドット集合体packing density
$$\rho = \left(\frac{W}{W+\delta}\right)^2$$
 $N_f = \frac{4\pi}{3} \left(\frac{2}{\rho}, \frac{K_\perp}{2\pi M_s^2} + 1\right) = \frac{4\pi}{3} \left\{ 2 \left(\frac{W+\delta}{W}\right)^2, \frac{K_\perp}{2\pi M_s^2} + 1 \right\}$ \downarrow_{x} $\frac{K_\perp}{2\pi M_s^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{W}{W+\delta}\right)^2 \left[3 \left(\frac{W}{W+\delta}\right)^2 - 1 \right] + \frac{3W^2}{\pi^3 L(W+\delta)} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^3} \sin^2 \frac{m\pi W}{W+\delta} \left[1 - \exp\left(-\frac{2m\pi l}{W+\delta}\right) \right]$ $+ \frac{3(W+\delta)}{\pi^5 L} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{m^2 n^2 \sqrt{m^2 + n^2}} \sin^2 \frac{m\pi W}{W+\delta} \sin^2 \frac{n\pi W}{W+\delta} \left\{ 1 - \exp\left[-\frac{2\pi \sqrt{m^2 + n^2} L}{W+\delta}\right] \right\}$ 単一ドット $\pi p^2 N_{p,x} = 2p^2 \cot^{-1} \left(\frac{1}{p^2} \sqrt{1+2p^2}\right) - p(p^2-1) \cdot \log\left(\frac{\sqrt{1+2p^2}+p}{\sqrt{1+2p^2}-p}\right) + p^3 \cdot \log(3+2\sqrt{2})$ $-p \cdot \log\left(\frac{\sqrt{1+p^2}+p}{\sqrt{1+p^2}-p}\right) - 2p^2 \sqrt{1+p^2} + \frac{2}{3}p^3 + 2p^2 \sqrt{1+2p^2} - \frac{2}{3}(1+2p^2)^{3/2}$ $N_{p,x,y} = \frac{1}{2} (1-N_{p,z})$ $\Delta N_{x-z} = (N_{p,x,y} - N_{p,z})$

H. Fujiwara, JPSJ **20**, 2092 (1965); T. Iwata et al. JAP **37**, 1285 (1966). その後, 異なる格子に対する計算も行われている. M. Masuda et al. JJAP **26**, 1680 (1987); H. Daimon & O. Kitakami, JJAP **30**, 282 (1991).

ドット集合体及び単一ドットの反磁界係数

形状異方性
$$K_{\text{eff}} = K_{\text{u}} + \frac{1}{2} \left(N_{\text{p}_x, y} - N_{\text{p}_z} \right) M_{\text{s}}^2 = K_{\text{u}} + \frac{1}{2} \Delta N_{\text{p}_x, z} M_{\text{s}}^2 > 0$$

磁化曲線傾斜 $\alpha = \frac{dM}{dH} = 4\pi \frac{1}{\Delta N} = 4\pi \frac{1}{N_{\text{f}} - N_{\text{p}_z}}$





Fig.5

5 Tbpsiの原理的な可能性について

BPMに課される条件

$$(N_{f} - N_{p_{z}}) < M_{s} > \leq H_{K}^{eff} \leq H_{head}^{max} - (N_{f} - N_{p_{z}}) < M_{s} > \dots (9)$$

$$M_{s} V H_{K}^{eff} \left(1 - \frac{(N_{f} - N_{p_{z}}) < M_{s} >}{H_{K}^{eff}}\right)^{2} \geq 80 k_{B} T \dots (10)$$

以降の議論を具体的に進めるために、現実に近い以下の2条件を設定する.

a. 記録ヘッドが発生しうる最大磁場 H_{head}^{max} = 16 kOe. ·····(11)

b. 双極子場 $(N_f - N_{p_z}) < M_s > = \Delta N < M_s > は有効異方性場<math>H_{\kappa}^{\text{eff}}$ の<u>1/5以下</u>.

 $H_{\rm K}^{\rm eff} \ge 5 \, \Delta N \, \langle M_{\rm s} \rangle$ (12)

5 Tbpsiの原理的な可能性について

H_{head}^{max} = 16 kOe を (9), (10) に代入して

$$H_{\rm K}^{\rm eff} \leq \frac{5}{6} H_{\rm head}^{\rm max} = 13.3 \, \rm kOe \qquad \cdots \cdots (13)$$
$$M_{\rm s} \, V \, H_{\rm K}^{\rm eff} \geq 125 \, k_{\rm B} \, T = 5.2 \times 10^{-12} \, \rm erg \ at \ 300 \, \rm K \qquad \cdots \cdots (14)$$
$$H_{\rm K}^{\rm eff} \geq 5 \, \Delta N \, < M_{\rm s} > \qquad \cdots \cdots (12)$$

式(13)において,許容異方性磁場の限界 H_K = 13.3 kOeをとると,式(14)より

$$V \ge \frac{3.9 \times 10^5}{M_s} \text{ [nm}^3\text{]} = 1300 \ (M_s = 300 \text{ emu/cc}) \\ 800 \ (M_s = 500) \\ 500 \ (M_s = 800) \\ 400 \ (M_s = 1000) \end{aligned}$$
(14')

式(12)と(14')を同時に満足する解があるかどうかが 5 Tbpsiの実現可能性を決める.

*M*_s = 300 emu/ccの材料を用いた場合

式(12)
$$H_{\rm K}^{\rm eff} \ge 5 \Delta N < M_{\rm s} >$$
より
 $\Delta N \le \frac{H_{\rm K}^{\rm eff}}{5 < M_{\rm s} >} = \frac{1.33 \times 10^4}{5 \rho M_{\rm s}} = 4 \pi \frac{0.7}{\rho} \qquad 0 < \rho \le 1$

右図を見てわかるように、この不等式は今回 計算した全サイズ領域

$0 < W \leq 11.4 \text{ nm}, 0 < L \leq 15 \text{ nm}$

に於いて満足される. また式(14')よりV≧ 1300 nm³ でなければな らないが, これは例えば

W = 10 nm, L = 13 nm

とすることにより容易に満足される. したがっ て, $M_{\rm s}$ = 300 emu/ccの場合には5 Tbpsiの 解は存在する. ちなみにこの場合の実効異 方性定数は

$$K_{\rm eff} = \frac{1}{2} M_{\rm s} H_{\rm K}^{\rm eff} = 2 \times 10^6 \, {\rm erg/cc}$$

材料的にも対応可能



5 Tbpsiの原理的な可能性について

- 1. 簡単な試算より、5 Tbpsi という超高密度記録は BPM により原理的 に実現可能との見通しが得られた.
- 2. BPM 設計にあたっては、双極子相互作用の制御が重要である.
- 3. 双極子相互作用軽減のためには

磁化M。ドット体積 ドット厚

の低減が非常に有効である.

BPM用磁性材料

Co/Pt		Table 1 Magnetic properties & characteristic length for various magnetic materials									
	materials	$M_{\rm s}({\rm emu/cc})$	$K_u(erg/cc)$	H _K (kOe)	$Q (K_u/2\pi M_s^2)$	$d_{\rm c}({\rm nm})^*$	$l_{ex}(nm)^{**}$	$\delta_{\mathrm{w}}(\mathrm{nm})^{***}$	memo		
	hcp Co	1400	4.2×10 ⁶	6	0.34	84	29	22			
	hcp Co ₈₀ Pt ₂₀	1200	13	22	1.4	170	34	12	$H_n > H_p$		
	L1 ₀ FePt	1100	70	128	9.2	400	26	4	$H_{\rm n} \sim H_{\rm p}$		
	L11 CoPt	950	35	73	6.2	380	30	3			
	Co/Pt *	1650 (/Co)	27 (/Co)	12	1.6	1000		3.5	$H_n > H_p$		
		[380]	[6.2]		[6.8]						

☆ The data for [Co(0.6nm)/Pt(2.0nm)]3 are quoted from the master thesis of T. Kato at Tohoku Univ.

The numbers in parentheses are the values averaged over total volume.

* Critical diameter for single-domain spherical particle : $d_{c} = 9 \gamma_{w} / (2 \pi M_{s}^{2}) - \gamma_{w}$: wall energy density

** Exchange length for spherical particle : $l_{ex} = 2r_{ex} = q \sqrt{6A/\pi M^2}$

*** Wall width

L1₁ CoNi-Pt



Table I Values of K_u , K_u/M_s and S, for L1₁-type Co-Pt and Co-Ni-Pt films having M_s of 500-600 emu/cm³.

Comp	osition	(at%)	M.	K, (x10 ⁷	<u>Қ</u> /М.	5
Со	Ni	Pt	(emu/cm³)	erg/cm ³)	(kOe)	
50	0	50	940	3.7	39.5	0.5
30	0	70	600	1.2	19.4	0.19
25	0	75	510	0.7	14.4	0.13
20	30	50	570	1.8	31.4	0.45
15	60	25	520	0.8	14.6	0.3

L11-Co50Pt50

ナノ磁性体研究の必要性





Bit size is comparable to characteristic length, such as

exchange length $L_{ex} \approx \sqrt{A/M_s}$ or $\delta_w \approx \pi \sqrt{A/K_u}$ domain wall width $\delta_w \approx \pi \sqrt{A/K_u}$ IIIIIIHow does such a tiny magnet behave
in response to H, T, etc ?

マイクロマグネティクスの予測



Critical boundary for coherent/incoherent rotation

$$L_{ex} = \frac{2 q}{M_s} \sqrt{\frac{2 A}{N_x}} \sim 35 \text{ nm}$$

for L1₀ FePt particle with aspect ratio of 1/5
for $D \leq L_{ex} \rightarrow \text{ coherent rotation}$
for $D > L_{ex} \rightarrow \text{ incoherent rotation}$
(curling or nucleation)

[A. Aharoni, Theory of Ferromagnetism (Cambridge Univ. Press); O. Kitakami et al. JJAP 40, 4019 (2001)]

単一ドットの超高感度磁化検出



Developed AHE method



micro SQUID AHE **VSM SQUID** (present method) (Neel lab.) ~ 10⁻¹⁵ emu ~ 10 ⁻⁴ emu ~ 10 ⁻⁷ emu ~ 10 ⁻¹⁵ emu **Sensitivity Max Field** $H_{max} = 20 \text{ kOe}$ $H_{max} = 50 \text{ kOe}$ $H_{max} = 90 \text{ kOe}$ $H_{max} = 90 \text{ kOe}$ Max Temp $T_{meas} < 9 K$

[N. Kikuchi et al. Appl. Phys. Lett. 82, 4313 (2003)] 22



Critical size for coherent / incoherent switching



For the first time, we have clarified that FePt dot behaves in a coherent manner when the dot size is smaller than nearly half the exchange length. ($D < L_{ex}/2$)

BPM用ナノドット格子の問題

A. Interdot dipolar interaction



degradation of thermal stability broadening of effective SFD

<u>reduction of <M> , V_{dot} , L/W is necessary</u>

B. Switching Field Distribution

extrinsic factors :

size dispersion, etching damage etc.

intrinsic factors :

structural defects, such as c-axis dispersion, lattice defects, layer imperfection, etc.





 $N_{\rm f}$: macroscopic demagnetizing factor $N_{\rm p_z}$: demagnetizing factor of a reversal unit $<M_{\rm s}>$: average saturation magnetization

Materials being investigated : (1) hcp Co-Pt (2) Co/Pt (3) L1₁ CoPt (4) Hard/Soft stack

hcp Co-Pt ドット格子

Crystalline size: ~ 15 nmc-axis dispersion: $\Delta \theta_{50} = 2.8^{\circ}$ Magnetization: $M_s = 1180 \text{ emu/cc}$ Magnetic anisotropy : $K_u = 1.24 \times 10^7 \text{ erg/cc}$ Anisotropy field: $H_K = 20 \text{ kOe}$





(b)

5.00 pt

3.00 pr

(a)



反転磁場のドットサイズ依存性



 $H_{\rm k}^{\rm eff}$ roughly explains the D dependence of H_0 , but H_0 decreases more rapidly than $H_{\rm k}^{\rm eff}$.

反転磁場, SFDに及ぼす c 軸分散の影響



反転磁場,SFDに及ぼすc軸分散の影響

[K. Mitsuzuka, et al. J. Magn. Soc. Jpn, 30, 100 (2006)]



Reduction of *c*-axis dispersion would be crucial for lowering SFD

L1₁ CoPtドット格子

[H. Sato et al. JAP 103, 07E114 (2008); ibid (in press)]



まとめ

- 1. BPMを用いたテラビット記録の可能性について試算した結果,少なくとも5 Tbpsi を 越える高密度化は原理的に可能と予測される.ただし,ドット間相互作用の設計・制 御が重要なポイントである.
- 2. BPM用材料として適当な磁化を有するCo/Pd, Pt やL1₁ Co(Ni)Ptが現状では有望 と考えられる.
- サブミクロンCo/Ptドットの磁化反転様式,双安定条件を明らかにした.高速パルス 反転実験などから,その反転様式は磁壁厚程度の反転核生成→磁壁伝搬で進行 することが実証された.今後は、BPMサイズ領域 (~10 nm)にまで踏み込み、ナノ磁 性体の振舞いを調べる必要がある.
- 4. hcp Co-Pt, L1, CoPt ドット格子の実験から, SFDには個々の結晶粒の結晶軸分散 が深く関与していることが示唆された. 今後は, 微細加工時のダメージ, バラつき, 材 料中の格子欠陥も含め, より踏み込んだ調査が必要.